PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43) Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number : 03-094863

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

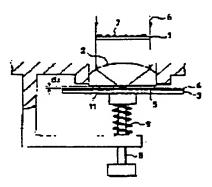
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAeeaGrbDA404305917P1.htm

11/6/03

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公野番号

特開平4-305917

(43)公債日 平成4年(1992)10月28日

(51) Int.CL'	說例記号	庁内整理部号	F 3	技術表示當所
H01L 21/027		7013—4M 7352—4M	H01L 2L/30	341 S 311 A

容置請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

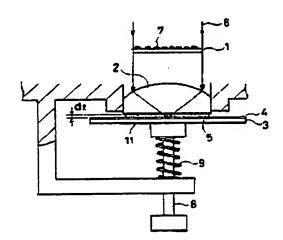
2番3号
第3号 株式
50E ###
第3号 新式
4

(54) 【発明の名称】 密智数質光装置

(57) 【要約】

(目的) 布着型電光袋話において、投液の膜障を持く して光の吸収量を少なくし、電光ムラを軽減助止するこ とを目的とする。

【特成】 総光レンズの参着国11をアルコール等の親水溶液によって税水化処理する。この親水化処理された 密若面11にフォトレジスト4を動布されたウエハ3を 浸紋5を介して密着させ、開射光6の照射によりフォトマスク1のパターンでをウエハ3上に転写する。税水化処理された密若面11は、吸水性が向上し、浸液5の膜 厚を薄くする。



--97--

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八倍若面を観水化処理し、この観水化処理された密着官 にフォトレジストを施布されたウエハを提抜を介して密 着させ、風射光の風射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密有型露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影席光 する露光装包、特に密整型露光被置に関するものであ る.

[0002]

【往来の往桁】 レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の学導 体基症上に投影器光するこの種の質光装置における発光 方式としては、①杏菊(コンタクト)電光方式、②プロ キシミティ観光方式、③反射型投影観光方式、④輸小レ ンズ投影解光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着傷光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて観光する もので、これらが完全に告着している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像皮の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密碧を実現することは観 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを複雑的に接 触させているためにウエハ衰菌の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩程りに影響を及ぼすといった問題があった。

【0004】そこで、宿着蝦光方式によるこのような問 姫を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体 (複数)を光環している。図2は投影光学系にウエハを 告着させた場合を示すもので、1 はフォトマスク、2 は 投影光学系の一部を構成する鑑光レンズ、3はフォトレ ジスト4が整布されたウエハ、5は軽光レンズ2とウエ ハ3間に充資された侵跡、6はフォトマスク1のパター ンでを思射しファトレジスト4を解光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 である。 風射光 6 の飲長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 徳霞が用いられる。 役款 5 としては、屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を稼かさないものが望ましく。 過常純水が使用 される.

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような受飲るを使用した密着型は光线管においては、 没被5百身の腹厚ムラがあると、浸液5による照射光6 50 電光装置によれば、投影光学系をたはフォトマスクのウ

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に転光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような観光ムラの発生を防止する ため、役被5の競坏は1を得くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

[0006] 本発明は上途したような従来の問題点およ び夏望に進みてなされたもので、その目的とするところ は、浸波の膜阜を輝くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密若型産光袋母を提供することにある。

[0007]

[改竄を祭決するための手段] 本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 **着面を観水化処理し、この根水化処理された密着面にフ** オトレジストを強布されたウエハを浸痰を介して密管さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにしたものである。

[8000]

[作用] 本発明において、職水化処理された技形光学系 20 もしくはフォトマスクのウエハ告着画は、吸水性が向上 し、受液の膜厚を誇くする。

100091

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る審着型離光装置の 一奏鮑例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一緯度部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省路する。本実施例は投影光学系にウエハを表 粉させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を病成する繋光シンズ2のウエハ密若面11を予め 80 親水化処理し、この鴨水化処理された密岩面11にウエ ハ3を拡水等の受抗5を介して衝着させ、照射光6の限 射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

[0010] 短水化処理は、アルコール系等の頼水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密常面11 にウエハ3を接接もを介して密着させ、ウエハ3を算光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】 かくしてこのような構成においては、戦水 レウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの で、観水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、砂液5の衰間張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、役款5の製厚は2 を図 2 に示した従来装置と比較して導くする (d2 <d1) ことができ、また膜原が深くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、軽光 ムラを経済防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本ி明に係る密着部

(3)

特別平4-305917

エハ密君面を貫水化処理し、この機水化処理された密管 略に、フォトレジストを整布されたウエハを侵滅を介し て密着させるように構成したので、民族自身の表面競力 を減らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、投放の競撃を輝くするかでき、また観撃が奪くなれ ば役款の鉄厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、設法による開光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【四1】本発明に係る密着四韓光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】密着型線光装配の従来例を示す妥邸の転面図で

85.

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 第光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸渍
- 6 照射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面

